



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**H547**

对应国外型号  
BC547

### 主要用途

开关和射频放大。

### 极限值 ( $T_a=25$ )

$T_{stg}$ ——贮存温度.....	-55~150
$T_j$ ——结温.....	150
$P_C$ ——集电极耗散功率.....	500mW
$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压.....	50V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压.....	45V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压.....	6V
$I_C$ ——集电极电流.....	100mA

### 电参数 ( $T_a=25$ )

### 外形图及引脚排列



参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			15	nA	$V_{CB}=30V, I_E=0$
HFE	直流电流增益	110		800		$V_{CE}=5V, I_C=2mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		0.09	0.25	V	$I_C=10mA, I_B=0.5mA$
			0.2	0.6	V	$I_C=100mA, I_B=5mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压		0.7		V	$I_C=10mA, I_B=0.5mA$
			0.9		V	$I_C=100mA, I_B=5mA$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压	0.58	0.66	0.7	V	$V_{CE}=5V, I_C=2mA$
				0.72	V	$V_{CE}=5V, I_C=10mA$
$f_T$	特征频率		300		MHZ	$V_{CE}=5V, I_C=10mA, f=100MHZ$
NF	噪声系数		2	10	dB	$V_{CE}=5V, I_C=200\mu A, f=1KHZ, R_g=2K$

### 分档及其标志

A	B	C
110—220	200—450	420—800